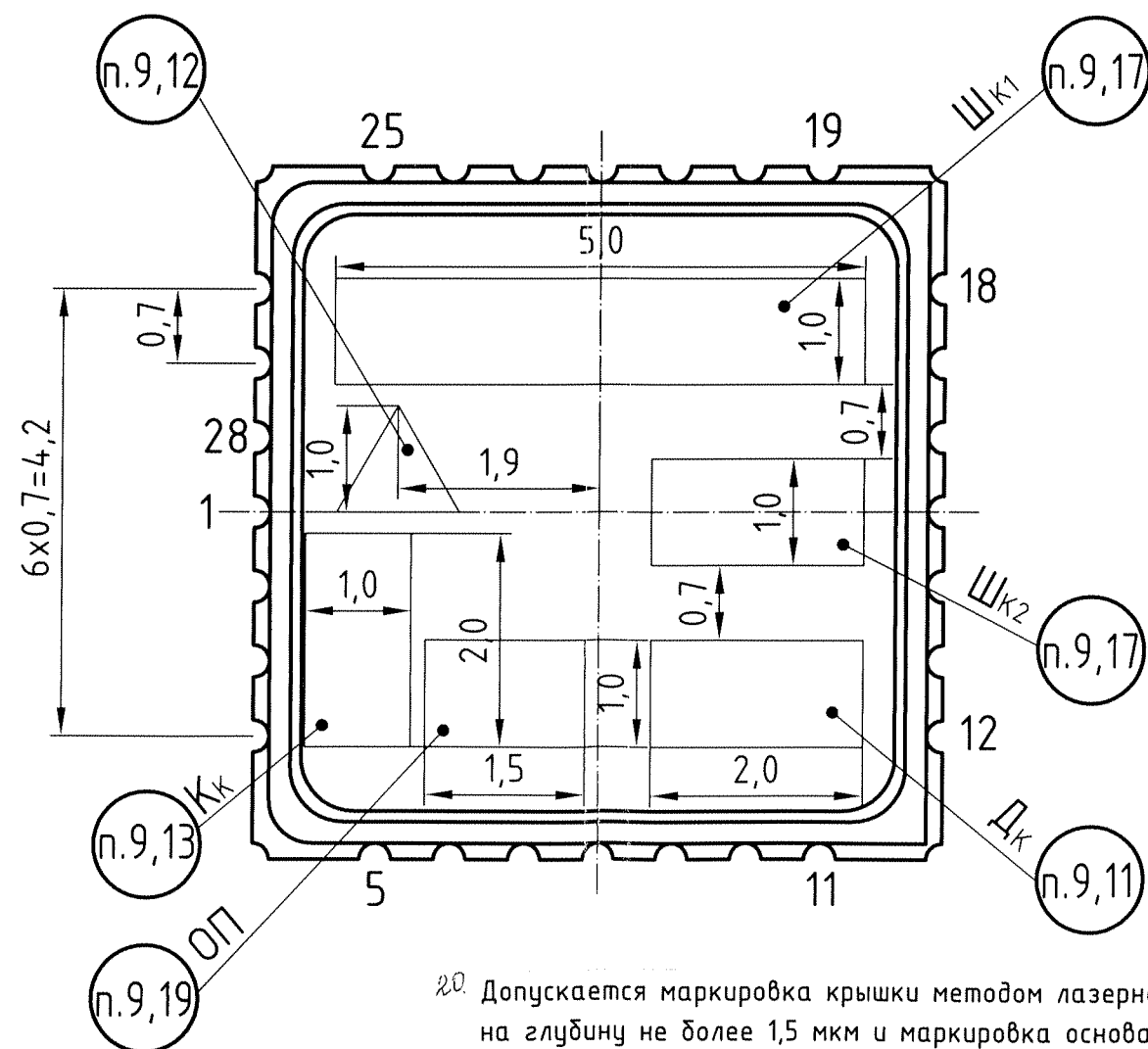
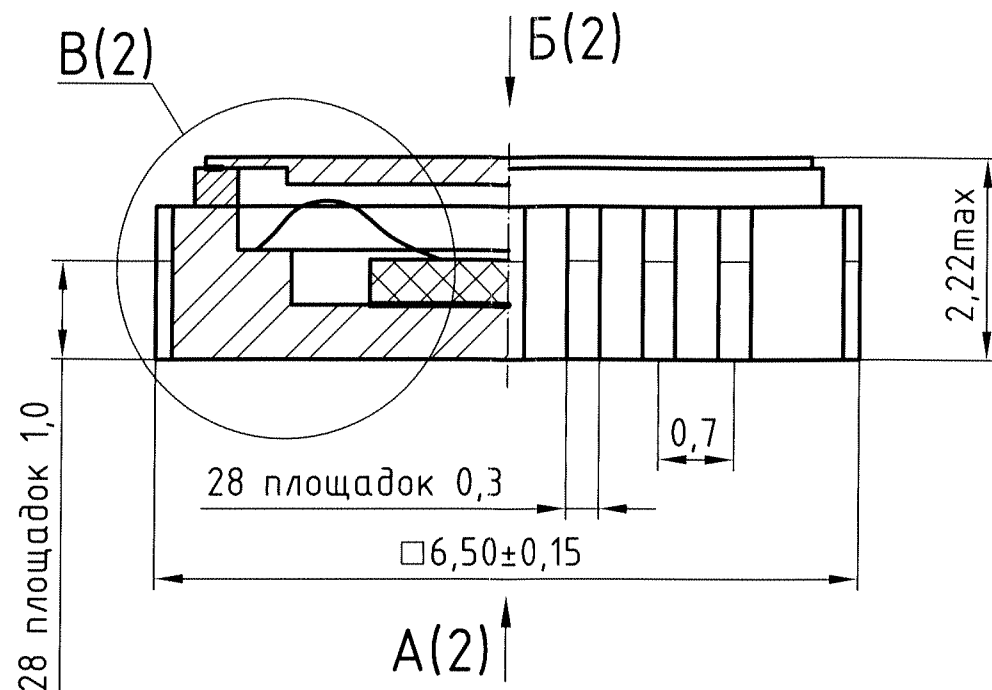


ГБЛ.431260.018-01СБ



20. Допускается маркировка крышки методом лазерной гравировки на глубину не более 1,5 мкм и маркировка основания корпуса методом лазерной гравировки на глубину не более 30 мкм.

1. Размеры для справок.
2. Микросхема должна соответствовать техническим условиям АЕЯР.431260.159ТУ.
3. Обозначение выводов показано условно и соответствует схеме электрической структурной ГВЛ.431260.018Э1. Контакт 15 соответствует шине "Земля". Контакт 1 соответствует шине "Питание".
4. Разварку алюминиевой проволоки поз. 3 между контактными площадками кристалла и траверсами корпуса производить методом ультразвуковой сварки. Не допускается касание проволочным проводником открытых участков кристалла и основания корпуса.
5. Минимальное расстояние между проволочными межсоединениями и незащищенными участками поверхности кристалла должна быть не менее диаметра развариваемой проволоки. Величина Д - максимальная стрела прогиба проводника.
6. Герметизацию корпуса производить методом шовной контактной сварки. При этом допускается смещение крышки в пределах ободка основания по ОСТ 11 14.5002, допускается наплыв металла по контуру крышки.
7. Показатель герметичности определяется по скорости утечки по эквивалентному нормализованному потоку и должен быть не более $6,65 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{см}^3 / \text{с}$. Допускается проводить проверку герметичности другими методами, указанными в ОСТ 11 073.013-2008.
8. Внешний вид микросхем должен соответствовать описанию образцов внешнего вида ГВЛ.431260.460Д2.
9. Маркировать составом маркировочным эпоксидным черным МКЭЧ-1 РМ11.028.002-83 по ГОСТ 2.314-68 Дк, Шк, Нк, Кк, ОП знак Δ , регистрационный номер карты заказа шрифтом ПО-1,0 согласно виду сверху.
10. С обратной стороны маркировать согласно виду А.
11. Дк маркировать четырьмя цифрами: две первые цифры обозначают год изготовления (последние две цифры года); две вторые цифры обозначают календарную неделю года.
12. Δ - знак чувствительности к статическому электричеству, равносторонний треугольник, основание которого совпадает с осью первого вывода микросхемы.
13. Допускается нанесение клейма ВП и клейма ОП производить одновременно с маркировкой микросхемы.
14. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 30668-2000.
15. Кристалл поз.1 клеить к основанию корпуса поз.2 клеем ВК26М ТУ 1-592-224-85 в соответствии с требованиями технологической документации. Не допускается попадание клея на кристалл и контактные площадки основания корпуса. Допускается использовать клей ТОК2 ШКФЛО.028.002ТУ.
16. Общее содержание драгоценных металлов соответствует данным справочного листа ГВЛ.431260.018Д1.
17. При маркировке микросхем в зоне Шк1 указывать "5503ХМ1У", в зоне Шк2 - "XXX", в зоне Шк3 - "03-XXX", где XXX - трехзначный регистрационный номер карты заказа.
18. Маркировку макетных образцов выполнять только в зонах Шк1 и Шк2 по пункту 17.
19. Микросхемы опытных партий дополнительно маркируются клеймом ОП.

Нач. 512 ВП МО РФ

И.А. Фронтов

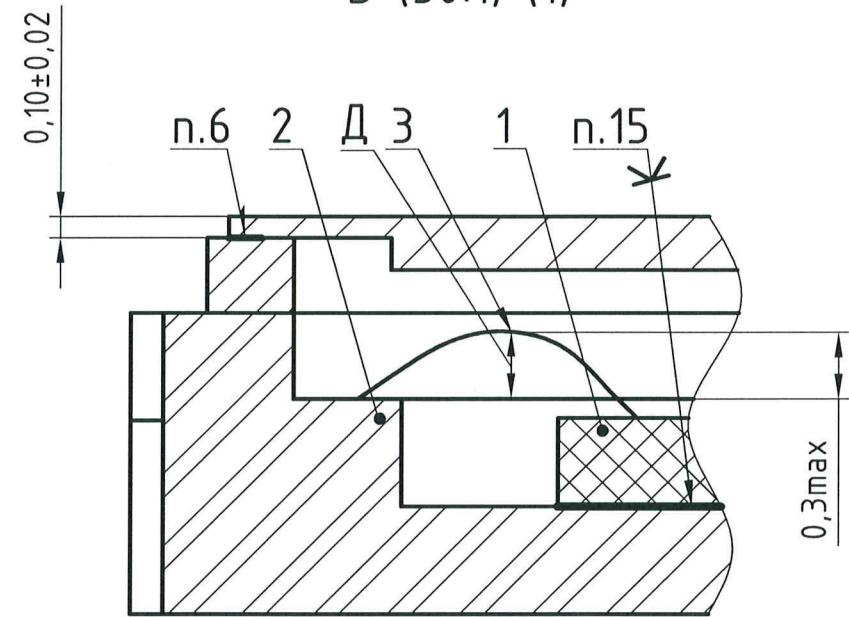
ГВЛ.431260.018-01СБ

					Лит.			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Микросхема интегральная 5503ХМ1У Сборочный чертеж			0,5г.		15:1	
Разраб.	Жарова	24.11.14	24.11.14	24.11.14				Лист 1		Листов 2	
Пров.	Казаков	24.11.14	24.11.14	24.11.14							
Т. контр.	Терпигорева	24.11.14	24.11.14	24.11.14							
Н. контр.	Васильев	24.11.14	24.11.14	24.11.14							
Утв.	Денисов	24.11.14	24.11.14	24.11.14							

Копировал:

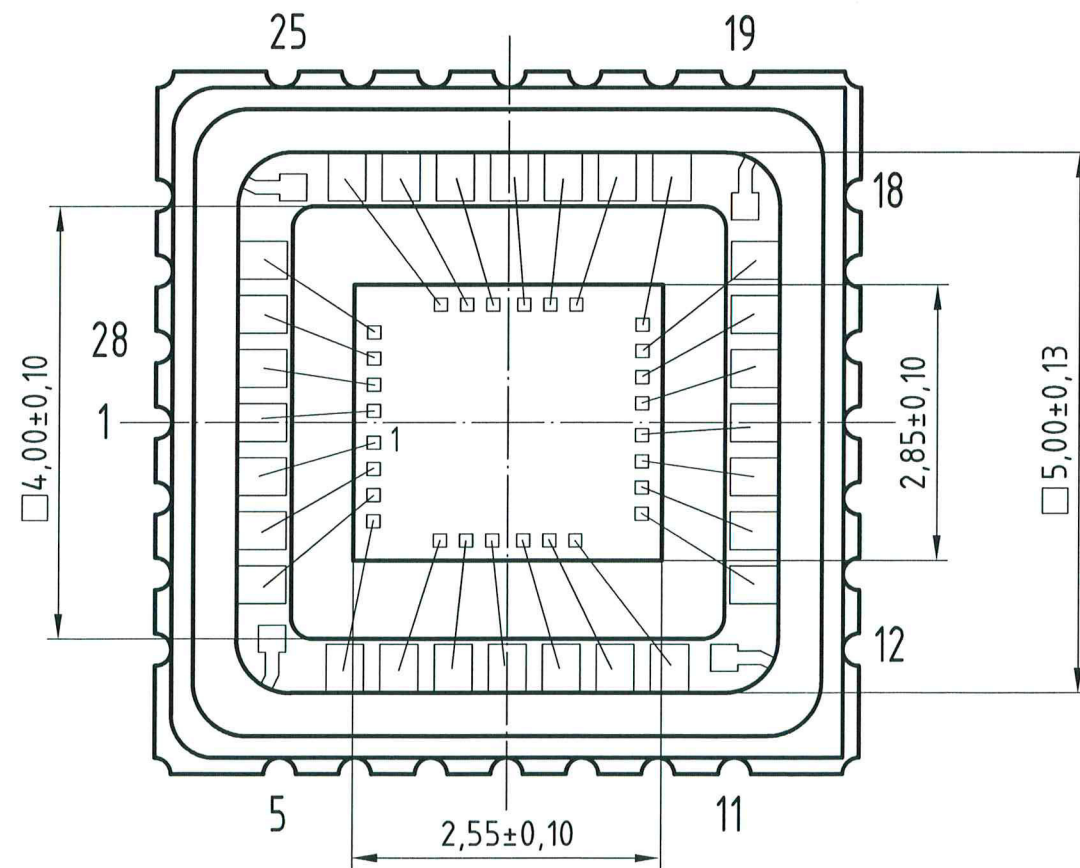
Формат А3

В (30:1) (1)

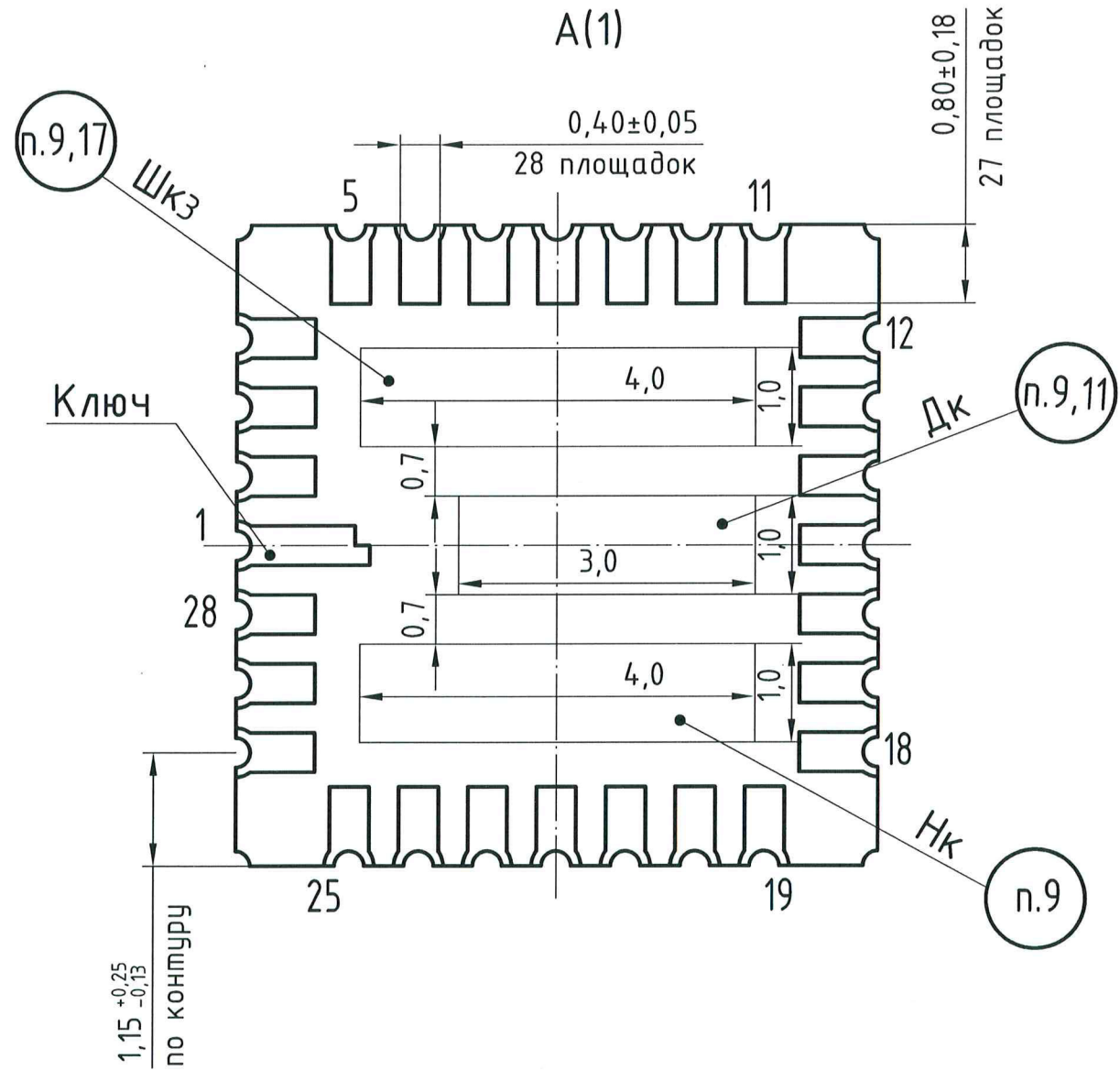


Б(1)

крышка не показана



А(1)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
265	28.10.18			

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата

Г АВЛ.431260.018-01СБ

Лист
2

Копировал

Формат А3